

低 V_F 特性かつ、高 I_{FSM} 特性を実現

High I_{FSM} with Low V_F

ROHM
SEMICONDUCTOR

第3世代 SiCショットキーバリアダイオード

3rd Generation SiC Schottky Barrier Diodes

ROHM
GLOBAL TOP BRAND
SiC

SCS3 Series

Features

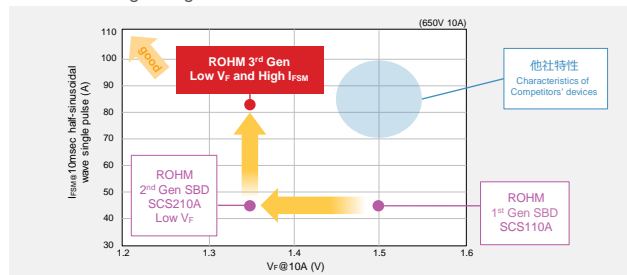
- **高 I_{FSM} 特性を低 V_F で実現**
High I_{FSM} with low forward voltage ($V_F = 1.35V$, $V_R=650V$ $I_F=$ Inominal)
- **低リーク特性**
Low leakage current
- **高速リカバリ特性**
High speed reverse recovery

Applications

- **太陽光パワーコンディショナ**
PV power conditioner
- **電源PFC**
PFC circuit in switching power supplies
- **充電ステーション**
EV Charger

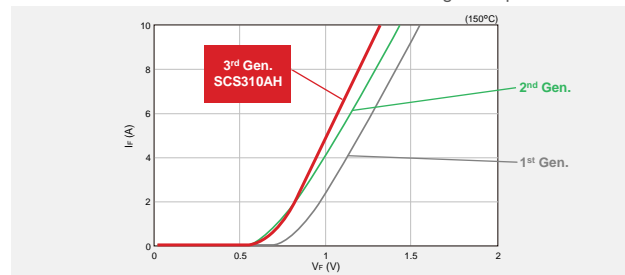
低 V_F ・高サージ電流耐量

Low V_F and High Surge Current Robustness



世代進化とともに高温時の低 V_F を実現

New Generation Enables Further V_F Reduction at High Temperature



ラインアップ

Lineup

Reverse Voltage V_{RM}	Forward Current I_F								Package
	2A	4A	6A	8A	10A	12A	15A	20A	
650V	SCS302AH	SCS304AH	SCS306AH	SCS308AH	SCS310AH	SCS312AH	SCS315AH	SCS320AH	TO-220ACP
	-	SCS304AM	SCS306AM	SCS308AM	SCS310AM	SCS312AM	SCS315AM	SCS320AM	TO-220FM
	SCS302AJ	SCS304AJ	SCS306AJ	SCS308AJ	SCS310AJ	SCS312AJ	SCS315AJ	SCS320AJ	TO-263AB (LPTL)